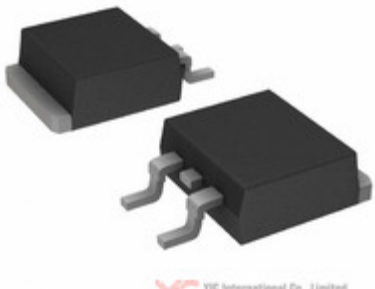









	<p><b>SQD35N05-26L-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQD35N05-26L-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 30A TO252</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQD35N05-26L-GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 15927 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQD35N05-26L-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 30A TO252
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	15927 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 55V 30A (Tc) 50W (Tc) Surface Mount TO-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1175pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SQD35N05-26L-GE3 ist neu im Original, Suche SQD35N05-26L-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQD35N05-26L-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQD35N05-26L-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SQD40031EL_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V</p>	 <p><b>SQD35N05-26L-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 55V 30A TO252</p>	 <p><b>SQD40061EL_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 40V</p>	 <p><b>SQD40030E_GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V TO252AA</p>
 <p><b>SQD40081EL_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 40V TO252</p>	 <p><b>SQD30N05-20L_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 55V 30A TO252</p>	 <p><b>SQD30N05-20L_GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 55V 30A TO252</p>	 <p><b>SQD35JA160</b> SANREX IGBT Modules</p>

heiße Teile

Mehr

# SQD200AA120	↔ SQD200AA60	⇒ SQD200M60	D SQD23N06-31L	⇒ SQD23N06-31L-GE3
⊥ SQD25N06-22L	# SQD25N06-22L-GE3	D SQD25N06-35L-GE3	⇒ SQD25N15-52-GE3	⇒ SQD300A(BA)60
# SQD300A40	⊥ SQD300A60	# SQD300A60E	↔ SQD300A60F	⇒ SQD300AA100
D SQD300AA100/	# SQD300AA100E	⊥ SQD300AA120	# SQD300AA60	⇒ SQD300BA60
⇒ SQD300H100	↔ SQD30N05-20L	# SQD30N05-20L-GE3	⊥ SQD35JA140	⇒ SQD35JA160
↔ SQD35N05-26L-GE3	⇒ SQD400A60	D SQD400A60N	# SQD400A60S	⊥ SQD400A60S/
# SQD400AA-120	D SQD400AA100	⇒ SQD400AA120	↔ SQD400AA60	⇒ SQD400BA60
⊥ SQD40N04-10A-GE3	# SQD40N06-14L	↔ SQD40N06-14L-GE3	⇒ SQD40N06-14L_GE3	⇒ SQD40N06-14L_GE3
# SQD40N06-25L-GE3	⊥ SQD40N06-25L-GE3	# SQD40N10-25	D SQD40N10-25-GE3	⇒ SQD40P10-40L-GE3
↔ SQD45N05-20L-GE3	# SQD45N05-20L-GE3	⊥ SQD45P03-12	# SQD45P03-12-GE3	⇒ SQD50A100

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited